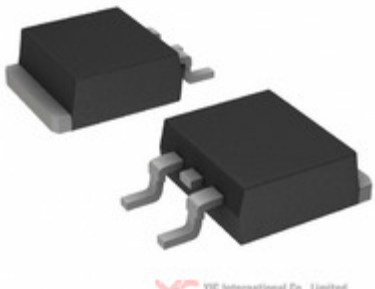
	<h2>UGB12JT-E3/81</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: UGB12JT-E3/81</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 12A TO263AB</p> <p>Datenblätter: 1.UGB12JT-E3/81.pdf 2.UGB12JT-E3/81.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






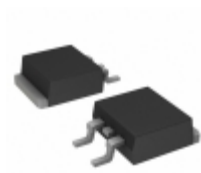


Spezifikationen

Teilenummer	UGB12JT-E3/81
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 12A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.75V @ 12A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 600V 12A Surface Mount TO-263AB
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	30µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	12A
Kapazität @ Vr, F	-

UGB12JT-E3/81 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, UGB12JT-E3/81-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, UGB12JT-E3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ UGB12JT-E3/81 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>UGB12JT-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 12A TO263AB</p>	 <p>UGB12JT-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 12A TO263AB</p>	 <p>UGB12JT-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 12A TO263AB</p>	 <p>UGB12JT-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 12A TO263AB</p>
 <p>UGB12JT-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 12A TO263AB</p>	 <p>UGB12JT-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 12A TO263AB</p>	 <p>UGB12JT-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 12A TO263AB</p>	 <p>UGB12JT-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 12A TO263AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

UGB12JT-E3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay	UGB12JT-E3/81 Datenblatt	UGB12JT-E3/81-Datenblätter	UGB12JT-E3/81 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay UGB12JT-E3/81
UGB12JT-E3/81 Electronic	UGB12JT-E3/81-Komponenten	UGB12JT-E3/81-Verteiler	UGB12JT-E3/81-Bild	UGB12JT-E3/81-Teil
UGB12JT-E3/81 Preis	UGB12JT-E3/81 Hersteller	UGB12JT-E3/81 Bild	UGB12JT-E3/81 Aktie	UGB12JT-E3/81 Inventar
UGB12JT-E3/81 Neu	UGB12JT-E3/81 Original	UGB12JT-E3/81 garantiert	UGB12JT-E3/81 RFQ	UGB12JT-E3/81 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited